

SPZ-EV40

真空蒸着装置

圧電材料の単結晶化を可能にする
下地層【独自のZrO₂ Buffer】の成膜に最適



特長

- ▶ 単結晶圧電薄膜に不可欠な下地層成膜が可能
- ▶ 基板回転機構により優れた膜厚分布および再現性を実現
- ▶ 搬送室予備ポートに蒸着チャンバーを増設可能

製品仕様

基板サイズ	Φ8inch(オプション: Φ6inch)	真空排気	クライオポンプ、ドライポンプ
基板ユニット	基板回転機構、基板バイアス	蒸着室真空圧	5.0E-5Pa以下
基板加熱	ハロゲンランプヒーター/最高800度	参考成膜レート	0.3Å/sec
蒸着材料	Zr(ジルコニウム)	制御系	PLC制御
Zr参考使用量	ルツボ投入重量 100g	操作系	デスクトップPC、液晶モニタ
膜厚制御	水晶振動子式膜厚センサ		

ユーティリティ(蒸着チャンバー1台仕様の場合)

電源	50/60Hz、3φ、AC200V、42kVA	冷却水	20~25℃ 45L/min以上
接地	A種	圧縮空気	0.5~0.7MPa
使用ガス	O ₂ (プロセス): 0.1~0.2MPa	クリーンドライエア	0.5MPa 100NL/min以上
	Ar(プロセス): 0.1~0.2MPa		
	N ₂ (リーク、再生): 0.1~0.2MPa		

※蒸着材料、使用ガス、冷却水チャラーは付属していません。

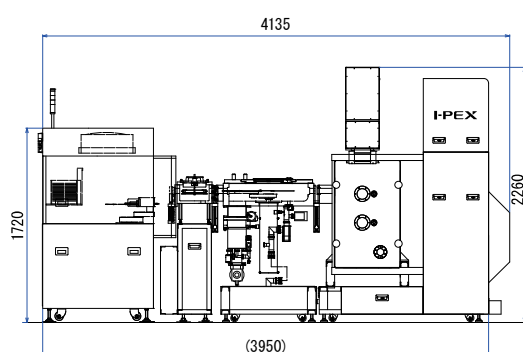
※記載の内容は予告なく変更する可能性があります。

SPZ-EV40

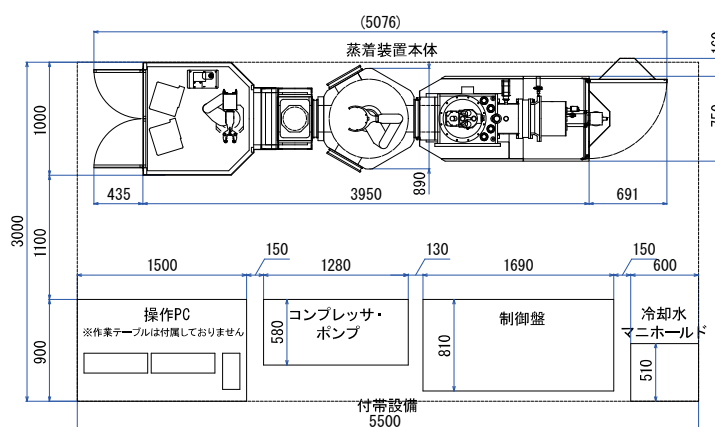
真空蒸着装置

真空蒸着装置外形寸法図(mm)

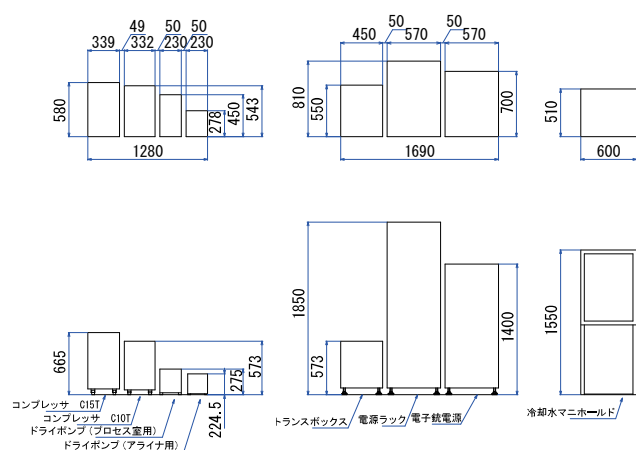
正面図



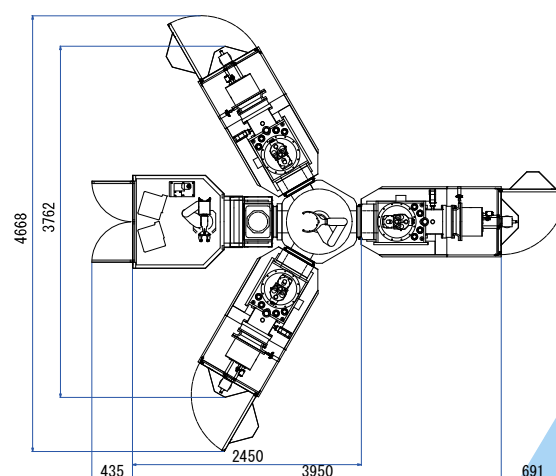
平面図



各付帯設備外形寸法図(mm)



真空蒸着装置チャンバー増設時 外形寸法図(mm)



※記載の内容は予告なく変更する可能性があります。

真空蒸着装置に関するお問い合わせ